

Полупроводник находится под стационарным внешним воздействием, выражающемся в инжекции в него электронов в сечении x_p . Диффузионная длина электронов $L_n = 0,01$ см.

Определить относительное уменьшение концентрации избыточных электронов на расстоянии x от места их введения $\Delta n(x+x_p)/\Delta n(x_p)$

Материал полупроводника Si. Расстояние x равно 0,04 см.